

Спосіб вирощування твердого розчину складу $\text{Ag}_3\text{As}_{0.8}\text{Sb}_{0.2}\text{S}_3$ методом спрямованої кристалізації з розплаву-розчину, за яким нагрівають вакуумовані кварцові ампули із попередньо синтезованих тернарних сульфідів Ag_3AsS_3 та Ag_3SbS_3 , взятих у стехіометричних співвідношеннях, зі швидкістю 100 К/год до температури 810 К і витримкою при цій температурі протягом 72 год, для гомогенізації розплаву одержаної шихти. Здійснюють подальше вирощування монокристалів у вакуумованих кварцових ампулах методом спрямованої кристалізації з розплаву при температурі 810 К протягом 48 год далі проводять відпал при температурі 623 К протягом 420 год. Швидкість вирощування кристала складає 0,1 мм/год, охолоджують монокристал до кімнатної температури зі швидкістю 5 К/год.